

从液相外延废液中回收高纯金属镓工艺方法

申请号/专利号： 00103907

本发明属于液相外延制备III—V族化合物半导体光电子材料领域，涉及一种对从液相外延废液中回收高纯金属镓工艺方法的改进。在废镓中加入浮游剂去除废镓中的铝杂质；利用高温高真空去除废镓中的Zn、As、Te等蒸气压高的杂质。用本发明回收高纯金属镓的杂质含量小于 $3\mu\text{g/g}$ ，用其生产的外延片的基本参数与采用日本进口高纯镓一致。对液相外延后的废液回收和再利用大幅度降低LED成本，是保证GaAlAs LED实现国产化的关键技术。

申请日：	2000年02月29日
公开日：	2001年09月05日
授权公告日：	
申请人/专利权人：	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
申请人地址：	吉林省长春市人民大街140号
发明设计人：	元金山;张富文;李向文
专利代理机构：	长春科宇专利代理有限责任公司
代理人：	梁爱荣
专利类型：	发明专利
分类号：	C22B58/00

点此查看跟该专利相关的 [主附图\公开说明书\授权说明书](#)